

2SA1284

低周波電力増幅用
シリコンPNPエピタキシャル形

概要

2SA1284は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタです。コレクタ損失が大きく、高耐圧に設計、製造されており、リレードライブ、電源や、20~40W出力の低周波電力増幅器のドライブ用として、2SC3244とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

特長

- コレクタ損失が大きい $P_c=900\text{mW}$
- 耐圧が高い $V_{CE0}=-100\text{V}$
- せん頭コレクタ電流が大きい $I_{CM}=-800\text{mA}$
- 利得帯域幅積が高い $f_T=130\text{MHz}$ 標準

用途

20~40Wアンプのコンプリメンタリドライブ用、リレードライブ、電源用

最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

記号	項目	定格値	単位
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-100	V
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-5	V
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-100	V
I_C	コレクタ電流	-500	mA
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-800	mA
P_c	コレクタ損失 ($T_a=25^\circ\text{C}$)	900	mW
T_j	接合部温度	+150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	保存温度	-55~+150	$^\circ\text{C}$

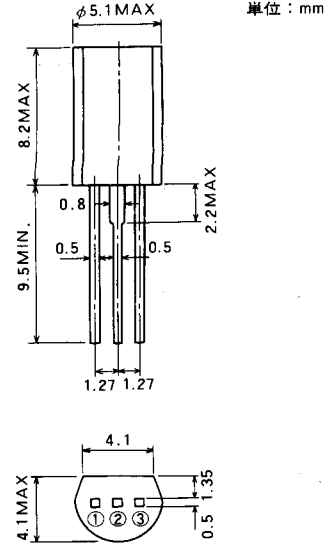
電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C=-10\mu\text{A}, I_E=0$	-100			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=-10\mu\text{A}, I_C=0$	-5			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=-1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	-100			V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB}=-50\text{V}, I_E=0$			-0.5	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB}=-2\text{V}, I_C=0$			-0.5	μA
h_{FE}	↑ 直流電流増幅率	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-10\text{mA}$	55		300	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C=-150\text{mA}, I_B=-15\text{mA}$		-0.15	-0.5	V
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE}=-10\text{V}, I_E=10\text{mA}$		130		MHz
C_{ob}	コレクタ出力容量	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		11		pF

†: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55~110	90~180	150~300

外形図



電極接続

- ①: エミッタ EIAJ: -
②: コレクタ JEDEC: -
③: ベース

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。